

磁場閉じ込め核融合研究分野におけるアーキング研究の 位置づけとその展望

Status and Prospects of Arcing in the Magnetic Confinement Fusion Studies

皇 甫 度 均 HWANGBO Dogyun 筑波大学 (原稿受付:2021年2月19日)

磁場閉じ込め核融合研究において、炉壁上で発生するアーキングは、炉壁の損耗を促進するとともに不純物 の発生源として懸念される.本解説では、金属壁の利用及び間欠的熱負荷の流入により発生するアーキング事例 を俯瞰するとともに、解明されつつあるヘリウムとタングステンの相互作用により形成される表面ナノ構造が アーキングに及ぼす変化について解説する.また、冷却用ガス導入とタングステン堆積がもたらすアーキング発 生環境の変化を展望する.

Keywords:

arcing, plasma-facing component, nanostructure, erosion, tungsten, divertor

1. はじめに

アーク放電は電極間における大電流及び低電位差を特徴 とする放電であり、様々な分野に応用されている.特に、 電極材を蒸発させた金属アークプラズマを用いたナノ材料 の合成[1,2],表面蒸着[3]および溶接[4]は、アークプラ ズマの特性を有効に活用している例と言える.一方で、電 力系統の真空遮断器[5,6]やプラズマ化学気相成長など、 半導体プロセスでのアーキング (arcing)[7,8]は抑制すべ き対象として研究されている.

磁場閉じ込め核融合装置ではプラズマに対して負の電位 を持つプラズマ対向壁上でアーキングが発生する.プラズ マを介して単一の電極表面で発生する「単極アーク」がそ の特徴であり、電極となるプラズマ対向壁には材料の蒸発 により生成されるクレータ(crater)がアーク痕を生成す る.したがって、アーキングにより炉壁表面は損耗し、不 純物が放出される.

1.1 アーキングの理論的背景

陰極表面上の特性が類似することから、単極アークの研究は陰極真空アーク(cathodic vacuum arc)を理論的背景 としている[9,10]. 陰極アークは他のアーク放電とは違っ て、極めて高い電流密度と非常に小さな陰極電圧降下(~ 20 V)を有する.

アーキングは表面からの電子放出によるブレークダウン (breakdown)から始まる[9]. 陰極表面には強い電場が 印加される.よって,アークの点弧は電界電子放出による ものが一般的である[11].プラズマ-材料界面ではシース 電場により電子放出が開始される. 微細突起,酸化膜など の誘電層,ガス吸着層,クラック(cracks)および過去に形 成されたクレータの縁など,表面状態により,局所領域か ら電界電子放出が開始する.その際,電流は電子放出ス ポットに集中するため,ジュール加熱によりスポットが加 熱される.温度上昇により(冷たい)電界電子放出は熱電 界電子放出に変化し,電流密度はさらに増加し,スポット はいずれ相転移のための臨界温度(critical temperature) に達する[12].

臨界温度に達したスポットは短時間で蒸発する.蒸気は 電子との衝突により励起・電離し,高密度の金属プラズマ を形成する.スポットからの多量の電子放出によりシース 間の電位差は減少し,表面には大電流ループが形成され る.この現象は爆発的電子放出 (explosive electron emission, ecton) と呼ばれ,陰極表面には蒸発とともにクレー タ模様のアーク痕が残る.陰極真空アークに関する詳しい 解説は[9,10]を参照されたい.

1.2 核融合炉におけるアーキングの歴史と炉壁を取り巻 く環境変化

核融合炉の磁場配位がリミター配位であった1970-80年 代まで、アーキングは炉心プラズマへの不純物の生成源と して主な要因の一つとして研究されていた.特に、リミ ター配位では炉壁が炉心プラズマと直接接していたため、 短時間で大量の不純物が発生し炉心プラズマ性能に大きな 問題を与えた[13-19].ダイバータ配位への移行後、AS-DEX 装置を中心に炭素壁ダイバータでのアーキングによ る影響の再評価がなされ、物理・化学スパッタリングに比 べ微小であることが一般的見解として定着した[20-22].

Plasma Research Center, University of Tsukuba, Tsukuba, IBARAKI 305-8577, Japan

author's e-mail: hwangbo@prc.tsukuba.ac.jp

一方、炭素壁ダイバータにおけるトリチウム吸蔵の問題 から全金属壁の実験が行われるようになり、また H-mode などプラズマ運転の高性能化や周辺局在化モード(edge localized modes; ELMs)を想定する運転シナリオが採択さ れるようになったことから、2000年代以降に再びアーキン グによる影響が検証された.検証実験のほとんどは炭素材 にタングステン(W)コーティングを施したダイバータ板 を用いて行われ、多数のアーキングが発見されるように なった.他方、プラズマ対向壁以外にも、計測装置やプラ ズマ加熱用部品の表面などでもアーキングが観測されるよ うになり、プラズマ診断や加熱への影響が懸念された.

近年,燃料以外に炉内に存在する,ヘリウム(He),ネオ ン(Ne),窒素(N₂)を始めとする反応副産物および冷却 用に導入する不純物ガスとの相互作用により,金属壁には 著しい表面構造変化が発生することがわかってきている [23-25].このような表面構造変化はアーキングの点弧特 性に大きな影響を与える.本解説では,ITERを含め金属 壁実験へ移行しつつある昨今の核融合炉実験装置における アーキングの発生事例を紹介する.また,Heおよび冷却用 ガスとWとの相互作用で生成される,繊維状ナノ構造 (fuzz)等の形成によるアーキングの点弧特性の変化およ び材料損傷の特性をまとめ,今後の核融合炉に及ぼす影響 を展望する.

2. 核融合実験装置におけるアーキングの発生例及 び表面状態との関係

2.1 ダイバータ板上でのアーキング

2000年代におけるアーキングを目的とした実験は、 ASDEX-Upgrade装置を用いて M. Laux らによって始めら れた. 図1で示すように、0.3-1µmの W コーティングを 施したグラファイトタイルにアーキングが発生した結果、



図1 ASDEX-U において 0.3 μm-W 膜上に形成されたアーク痕 [26].(a)アーク痕の拡大図.(b)一部の領域におけるアー ク痕幅.

W コーティング膜が完全に剥離した. アーク痕はジグザグ 運動をしながら, アーク電流と磁場が成すアンペール法則 の逆方向($-j \times B$, jはアーク電流, B は外部磁場), いわ ゆる retrograde 方向に直線運動した[26]. その後, 一連の 実験により多数のアーク痕が発見され[27-30], ELMsが誘 起する高電場シースがアーキングのトリガーになること [27], スパッタリングの数倍に及ぶ局所的損耗などが確認 された[28]. しかし, ダイバータ板全体で発生するスパッ タリングに対し, アーキングによる損耗は局所的であり, 絶対量として微小であることが確かめられた[28]. DIII-D でも同様の実験が行われ, ELMsによるアーキングの発生 が確認された[31]. ASDEX-Uと同様, アーキングは $-j \times B$ 方向に運動した. また, 全体の損耗量に対しアーキ ングによる損耗量は小さいことが示唆された[32].

アーキングによる損耗は流れる電流に依存するため、単 位電荷量当たりの質量損失量 (µg/C) が損耗率の指標とし てよく用いられる.金属の中でもWはアーキングによる損 耗量が非常に小さく、~20µg/Cと知られている.それは、 固相から気相へ相転移させるために必要なエネルギーが高 いためである[10].一方、鉄 (Fe)のような材料はWに比 べ損耗率が高く、~50µg/Cである[10].ASDEX-Uにおい てフェライト相系耐熱鋼 (P92)材を用いた実験では、P92 材でWの100倍以上の損耗が観測されている[28].した がって、ITER 後継の DEMO 炉など、低放射化フェライト 鋼の採用が検討される際にアーキングによる局所的な損耗 はより深刻化する可能性がある.

2.2 プラズマ計測系,加熱系でのアーキング

炉心プラズマの性能向上のために、イオンや電子の電磁 波による加熱がよく用いられる.また,高温高密度プラズ マの診断にも電磁波が必要である.しばしば電磁波の真空 容器内経路上には、プラズマに対向した反射ミラー等が設 置されるが、これらの装備は高熱流プラズマの直接接触が 想定されない領域であるにも関わらず、アーキングが発生 しやすい場所として知られる. JT-60U トカマクではプラ ズマから十分離れた位置にあるトムソン散乱計測用ミラー や、真空容器の外側の大気中にあるミラー表面にアーク痕 が発見された[33]. また, LHD (Large helical device) で は電子サイクロトロン放射計測用ミラー[34],レトロリフ レクター (retroreflector) の表面にアーク痕が発見された [35]. JET ではイオンサイクロトロン共鳴加熱 (ICRH) 用 の真空伝送路において,低電圧ブレークダウンに続いて アーキングが発生したことが報告されている[36]. これら のアーキングの発生機構は未解明な部分があり、商用核融 合装置の設計において不確実性をもたらすことが懸念され る.

2.3 グロー放電洗浄時のアーキング

プラズマ運転時以外に、グロー放電洗浄によってもアー キングは発生する.グロー放電洗浄時のアーキングの特徴 は、磁場を印加しないためスポットが直線方向の運動をし ないこと、運転時においてプラズマが直接流入せず、影に なっている領域でも発生することなどが挙げられる.

図2はステラレーター装置 Wendelstein 7-X (W7-X)の

真空容器内に形成されたアーク痕を表す[37]. グラファイ トダイバータテストユニットが設置された Operational Phase 1.2b までの期間に累積されたアーク痕である. ステ ンレススチール (SS) の真空容器 (図2(a)と(b)),ドップ ラー反射系のミラー (図2(e)),赤外・H_a線カメラポー トの表面 (図2(f))など,様々な場所でアーキングが発生 し,その痕跡はそれぞれ異なることがわかる.興味深いの は,SS容器の裏側 (図2(c))および炭素壁の支持と冷却を 担当する CuCrZr 構造の表面にもアーク痕が形成されたこ とである. 図2(f)を除く他のアーク痕はいずれも集合し た形状を有しており,磁場の影響を受けないグロー放電洗 浄時に発生していると思われる.

最近, LHD の重水素実験において, 装置の整備のために 真空容器を観察した結果, 多数のアーキングが新たに発生 していたことが報告された[38].容器内観察が行われたの はグロー放電洗浄と本プラズマ運転の間であり, グロー放 電洗浄によって誘起されるアーキングの直接的証拠として 重要な報告である.

2.4 材料および表面状態の影響

上述した LHD でのアーキング[38] は、高速イオン D_{α} 用ミラーのシャッターや駆動シャフト上に発生した.アー ク痕は大面積にかけて形成されており、アルミニウム (Al)の表面のみに選択的に発生していた.これは材質の 性質(仕事関数,熱伝導率,臨界温度等[9,10])により同 条件で異なる点弧特性を示す例である.また、図2(a)のよ うなエッジにおける凹凸構造、図2(b)のような表面の汚 染など、炉壁の表面状態はアーキングの点弧特性を大きく 変化させる.



図 2 Wendelstein 7-X の様々な場所で発生したアーク痕[37].
 (a) と(b) SS パネル前面, (c) SS パネル後面, (d) グラファイトバッフル支持体後面, (e) ドップラー反射系ミラー, (f) 光学用ポート表面.

3.ナノ構造上でのアーキングの発生と材料損耗 への影響

3.1 ナノ構造の核融合炉内での生成およびアーキング

核融合装置におけるアーキングは不意に発生することが ほとんどであり,発生時刻や発生場所における電圧電流変 化に関する情報は極めて少ない.そのため,点弧条件や特 性を理解するのが困難であった.実験室で単極アークを再 現する試みも,その発生条件の難しさから長年停滞してい た.

転機は He-W 相互作用により著しい表面構造変化が発生 する,ナノ構造の形成が発見されたことにある.図3(a)に He の入射イオンエネルギー 20 eV,W の表面温度 1000 K 以上の条件[39]で形成される典型的なナノ構造の断面図を 示す.直径数十 nm の円筒状構造が不規則に絡み合い,数 µm程度の層が表面に一様に形成されることが特徴である. その形状ゆえ,ナノ構造層の熱伝導率は通常の平板 W の約 1%未満となり[40],先端部における電界電子放出係数は 数百倍に増加する[41]ことが実験的に示された.

ナノ構造を用いることで,定常 He プラズマ-W 表面間 での単極アークの点弧が初めて報告された[42].図3(b) はナノ構造上で生成されるアーク痕の典型的な例を示す. 表面には直径2-5µm 程度のクレータが生成し,隣のク レータと連結して長い曲線状のトラックを形成する.ま た,トラック同士は絡み合って巨視的な迷路構造を形成す る.それ以降,ナノ構造 W を核融合実験装置に設置し,プ ラズマを照射する一連の実験が様々な装置で行われ,LHD [43],DIID-D[44],COMPASS[45]などでアーキングの 点弧が確認された.同時に設置された表面が滑らかな W 上ではアーキングが発生しなかったことから,ナノ構造の 性質がアーキングを誘発しやすいことも示された.また,



図3 (a) 典型的なタングステンナノ構造層の断面と(b)ナノ構造 層に残ったアーク痕.

ヘリカル装置である LHD を除き,トカマク装置でのアー キングは ELMs や Disruption などによる間欠的熱負荷の流 入時に発生した.これらの結果は,ナノ構造の形成により, 表面の温度上昇,シース電位差の上昇などアーキングの誘 起に適した環境が形成されることを示唆する.

3.2 ナノ構造上でのアーキングの電圧電流特性

梶田らにより,直線型定常プラズマ装置NAGDIS-IIにおいて,電気的に浮いている試料とプラズマ間で自発的に形成されるシース電位差が60 V以上となる条件において,間欠的熱負荷を模擬したレーザーパルスを表面に入射することで単極アークの誘起に成功した[42].それ以来,実験室プラズマの特長を生かした後続研究が活発に行われた.後続実験では定常プラズマのパラメータを柔軟に調整するため,試料に外部から負のバイアス電圧を印加することでシース電位差を調整している.

図4(a)に NAGDIS-II におけるアーキング点弧前後の電 流電圧波形の変化の例を示す. 試料を-70 V にバイアスし レーザーパルスを印加するとアーキングが誘起され、試料 電流はイオン飽和電流 (~0.7 A) から7A (電源設定値)ま で増加する.応答の速いバイポーラ電源を用いると図4 (a)のように瞬間的に設定値に達する反面,直流安定化電 源のような比較的立ち上がりが遅い電源の場合,アーク電 流は設定値を大幅に超えるまで増加し,ゆっくり減少しな がら設定値に近づく[46].アークスポットから多量の電子 が放出されると同時に、シース電圧は減少し、アーク動作 電圧と呼ばれる~30V程度を維持することが知られる [9]. 直線型直流プラズマ装置では、プラズマソース端の 陽極が接地されていることから、試料と陽極の間には磁力 線に沿って流れるプラズマ柱を介して大きな電流ループが 形成され、図4(b)のような電圧電流の直線的な変化が見 られる.アーク電流が大きくなるほど試料電圧は負に深く



図 4 (a) アーキング発生時の電流電圧の経時変化と(b)電圧電流 特性.

なり,その傾きはプラズマ柱の抵抗値 (Spitzer 抵抗) に等 しいことが示された[47].

3.3 ナノ構造上でのアーキングの発生条件

アークの点弧には、間欠的熱負荷による金属蒸気プラズ マの形成が必要である. 梶田らは、ELMsと同程度のパル ス長を有するルビーレーザーを用いた実験で、アーク点弧 に必要なレーザーパルスのエネルギー閾値が 0.01 MJ/m² であり、ELMsで想定される熱負荷より小さい負荷でアー キングが点弧可能であることを示した[48].

アークの維持のためには、金属蒸気プラズマによる電圧 降下分の最小動作電圧(=アーク動作電圧)が必要である ことが知られる[9].一方、プラズマ-金属間の単極アー クではシース電圧が重要な条件となる.NAGDIS-IIで は、プラズマに対して-60 V以下の電位差でアーキングの 点弧を確認した[48].一方で、PISCES-Aでは-100 V以下 の電圧を必要とした[49].この違いも使用された電源の応 答に起因すると思われる.外部電源を用いない Pilot-PSI での実験では、-70 V 程度の電位差が必要であることがわ かっている[50].

アーキングの点弧および持続にはシース電位差に加えて プラズマ温度や密度も重要と思われる.これらのパラメー タはシース電場強度に作用する.図5は PISCES-A を用い て行われたアーキング発生時のシース電圧および電場の依 存性を示している[47].シース電位差 100 V 以上,電場 2 MV/m 以上の条件を満たした時,アーキングが発生する ことがわかる.したがって,ELMs など高温高密度のプラ ズマの流入時はアーキングの発生しやすい環境であると言 える.

3.4 ナノ構造層の厚さとアーキングの挙動およびプラズ マ特性の関係

ナノ構造上のアークスポットの挙動およびプラズマ特性 の理解は,核融合炉における炉壁の損耗面積の推定および 発生した不純物の磁場を横切る挙動を理解するために重要 である.一方,アークスポットの挙動は磁場と局所的プラ ズマの相互作用の面で興味深い現象である.



図5 ナノ構造上のアーキングの発生条件[41].シース電位差と ともにシース電場に閾値が存在する.

上述のように、アークスポットは $-j \times B$ 方向に運動する が、ナノ構造上ではさらに特有のランダム運動性が観測さ れている.ランダム運動の指標として梶田ら[51]はフラク タル次元を持ち、微視的には完全なランダム運動をし、巨 視的には $-j \times B$ 方向に運動することを明らかにした.ま た、磁場強度によりスポットの直進性が増し、ナノ構造厚 さの増加とともに図3(b)のようなスポットの集団化が進 み、微視的なランダム運動性がより大きくなることを示し た.ナノ構造の厚みや外部磁場強度などの変化に対するス ポットの運動特性は、外部磁場の影響を考慮したモンテカ ルロシミュレーションにより模擬された[52].

ナノ構造厚さによるスポットの集団化はスポットの巨視 的運動速度にも影響を及ぼす.図6は異なる厚さを有する ナノ構造層を通るアークスポットの運動変化を高速カメラ で計測したものである[53].試料表面には上部1μm,下 部5μmのナノ構造層が形成されており,アークスポット の運動は境界を横切った瞬間から著しく変化している.ナ ノ構造層が厚い領域では集団化したスポットの進行により アーク痕の幅は広く,速度は遅い.それに対し,ナノ構造 層が薄くなると,スポットの集団化は見えなくなり,アー ク痕の幅は数分の一程度に細くなると同時に速度は数倍程 度に増加する[53].図7はHeプラズマパラメータおよび アーク電流を同一とした時のアーク痕の様子を示す.図7 (a)と図7(b)のように,ナノ構造厚さ1μmではアークス



図6 磁場と平行なナノ構造表面で自走するアークスポットの発 光[53].ナノ構造厚さの変化に反応し運動の形態も変化す る.



図7 磁場と平行なナノ構造面状のアーク痕. (a)と(b)は厚さ 1 μm, (c)と(d)は厚さ 3.5 μm 上のアーク痕を示す.

ポットの集団化が起きず,厚さが増加することにより集団 化が発生することがわかる(図7(c)と(d)).

一方,アークプラズマの温度および密度を評価する試み も行われている.しかし、スポットサイズが小さいことに より、未解明の点が多い.一般的に、アークプラズマは局 所的で高密度な金属蒸気プラズマであり、局所的熱平衡状 態(Localized thermal equilibrium, LTE)であることが知 られる[10]. したがって、W線スペクトルのボルツマン プロット法を用いて電子温度が評価できる.一方,西島ら [54]により W 線スペクトルのシュタルク拡がりが計測さ れ、アークプラズマの電子密度も評価された. 図8(a)はボ ルツマンプロット法により評価したアークプラズマの電子 温度のナノ構造厚さ依存性を示す[55].電子温度は 0.5-1.5 eV であり、ナノ構造厚さの増加とともに減少す る.一方,図8(b)に示すアークプラズマの電子密度はナ ノ構造厚さの増加とともに上昇する. 図8(c)はサハ-ボ ルツマン方程式を用いて計算した W 一価イオンと中性粒 子の比率であり、ナノ構造厚さの増加とともにアークプラ ズマの平均電離度が減少することを示す. これらの結果 は、アークスポット上においてナノ構造厚さの増加により 金属蒸気の発生量が増大し、電子とW蒸気間でエネルギー の緩和がより活発になることを示唆する[55].



図8 アークプラズマの(a)電子温度,(b)電子密度,(c)サハー ボルツマン方程式から推定した一価イオンと中性粒子の比 率のナノ構造厚さ依存性[55].

3.5 ナノ構造上でのアーキングによる材料損耗

アーキングによる材料損耗の指標としては,第2章で述 べた単位電荷当たり損耗量(mg/C)とともに単位時間当 たり損耗量(mg/s)も良く用いられる.上述のように,ナ ノ構造厚さの変化によりアークスポットの挙動および金属 蒸気の生成量は大幅に変化する.これらは,材料の損耗量 の変化にもつながる.図9はアーク電流およびナノ構造厚 さの変化に対する質量損失量の依存性を示す[47].まず, ナノ構造の生成により,材料の単位電荷当たり損耗量は最 小でも0.5 mg/C程度となり,平面Wの場合(~20µg/C [10])に比べ大幅に増加することがわかる.これは,ナノ 構造の熱・電気的特性に加え,高い空孔率により破壊され やすい性質に起因すると思われる.

ナノ構造厚さが一定(~2µm)の時,単位時間当たり損 耗量はアーク電流とともに増加するのに対し(図9(c)), 単位電荷当たり損耗量はアーク電流変化に依存しないこと がわかる (図9(a)). 一方で, アーク電流がより大きな値 で一定(~7 A)の時,単位電荷当たり損耗量はナノ構造厚 さが2µmを超えると著しく増加し、1.6 mg/C に達してい る(図9(b)).供給された電荷量が一定の条件における損 耗量の増加は、表面から荷電粒子以外の形で飛び出した W 粒子の量が増加したことを意味する. 図8(c)のようにW 中性粒子の比率が増加したことを考えると、蒸発して電離 しない W 粒子の量が増加したことが示唆される. 一方, 厚 さ2µm を境界に損耗量のジャンプが起きることはW粒子 の蒸発以外の損耗機構が存在する可能性を示す. 図7(d) で示すようなアークスポットの集団化は厚さ2µm を超え る時点で発生する[47]. これらの結果から、ナノ構造が厚 い場合はスポットが同一の場所で継続的に点弧することに よりその集団化が進行し、形成されたアークプラズマのも つ圧力が隣合うナノ構造を機械的に破壊し, droplet の形 でWを放出する機構が提案された[47].

3.6 ナノ構造上でのアーキングの理論的解析

上述のように、定常プラズマ-金属間のアーキングはナ ノ構造を媒体として主に実験的な手法で研究されてきた. 一方で、真空アークの長い歴史で作り上げられた理論を用 いてプラズマ-金属界面での単極アークを説明する試みも されてきている. Barengolts らは梶田らの実験結果を Ecton モデル[9]を用いて説明した[56]. そこでは、ス ポットが電流の集中によるジュール加熱で爆発に至るまで の間に投入される電流密度の積算が重要な指標として扱わ れる.ナノ構造 W の場合, 質量密度の減少, 熱拡散・伝導 率の減少により臨界温度に達するために必要な電流密度は 平面Wに比べ格段に低いことで,熱の伝播速度とクレータ の拡大速度のつり合いで決定されるクレータ半径の計算値 が実験結果と同程度であることを示した[47].また、ナノ 構造層の厚さがある程度以上になる時,スポットが同じ領 域で点弧を維持することでスポットの集団化が進行し, アーク痕の幅が広がりスポットの移動速度が減少すること も Ecton モデルを用いて説明された[57]. これらの試み は、プラズマシースを介する単極アーク環境も本質的に真 空アークの理論が適用可能であることを示すものであり, その重要性は高いと言える.

4. 今後の展望

ITER のダイバータ板は現存のトカマク装置より高い熱 負荷を定常・間欠的に経験する.De Temmerman らは W の損傷が支配的な外側ダイバータのストライク点付近にお いてナノ構造が生成可能な入射イオンエネルギー (>20 eV)および表面温度(>1000 K)条件を満たす領域 が存在することを示した[58,59].

本解説では,Heプラズマ照射がもたらすW表面変化として繊維状ナノ構造に関連したアーキング研究を取り上げた.一方,最近の研究で,HeイオンがもたらすW表面変



図9 アーキングによる材料損耗率のナノ構造厚さ依存性[47].(a)と(b)は単位電荷当たり損耗量,(c)と(d)は電位時間当たり損耗量を 示す.(a)と(c)はナノ構造厚さ2µmにおける損耗率のアーク電流依存性を,(b)と(d)はアーク電流7Aにおける損耗率のナノ構造 厚さ依存性を示す.



図10 ヘリウムプラズマにネオンガス(15%)を添加時生成され たナノ構造バンドル(NTBs).入射イオンエネルギー 200 eV,照射量 2×10²⁵ m⁻² である.

化には未だ解明されていない部分が多いことが示されてい る. そこには表面からの W のスパッタリング, または表面 への堆積が重要な役割を果たす.図10はHeにNeを15%混 合させたプラズマを W 表面に照射したときに生成される, ナノ構造バンドル (nano-tendril bundles, NTBs) の例を示 す. 表面に一様に分布するナノ構造層と違って, 高さ 100 µm に及ぶ巨大化した構造が表面上に分布する特徴を 有する.NTBsはWのスパッタリングと再堆積により選択 的に成長すると考えられている[60].孤立した突起状の形 状の発達により、熱の拡散を通常のナノ構造よりも低下さ せ、電界電子放出を大幅に増加させる[61].ゆえに、 NTBs 上では間欠的熱負荷の印加が無くてもアーキングが 発生できる[62]. NTBs 構造は試料温度 1200 K 以下[63] でも生成可能であることが示されている. さらに, Wの堆 積が支配的な場合には、表面構造の成長は通常の1000倍程 度まで速くなることも近年示されている[25].

核融合研究分野において,リミター配位からダイバータ 配位へ移り変わった後の数十年間は,アーキングは炉壁損 耗源・不純物発生源としてスパッタリングに比べ無視でき るとされてきた.しかし,核融合反応生成物として必ず存 在する He イオンおよびダイバータ冷却のための冷却用ガ ス,またW表面からのスパッタリングと再堆積プロセスが 成す複合的な環境下では予期せぬ表面変化が起こる可能性 がある.したがって,今後のアーキング研究は潜在的なW 表面変化がもたらすアーキング点弧特性を精査し,炉壁の 損耗と不純物の生成に占めるアーキングの割合や影響を明 らかにする必要がある.

参 考 文 献

- [1] 三重野哲:プラズマ・核融合学会誌 94,516 (2018).
- [2] Q. Wang et al., Chem. Soc. Rev. 42, 8821 (2013).
- [3] D.M. Sanders and A. Anders, Surf. Coat. Tech. 133, 78 (2000).
- [4] 平田好則,野村和史,荻野陽輔:プラズマ・核融合学会
 誌 87,535 (2011).
- [5] 丹羽芳充, 金子英治: プラズマ・核融合学会誌 81,5

(2005).

- [6] F. Yang et al., J. Phys. D: Appl. Phys. 46, 273001 (2013).
- [7] H.-S. Jun, Jpn. J. Appl. Phys. 52, 066202 (2013).
- [8] Y. Kasashima et al., Appl. Phys. Exp. 7, 096102 (2014).
- [9] G.A. Mesyats, *Cathode Phenomena in a Vacuum Discharge: The Breakdown, the Spark and the Arc* (Nauka, Moscow, 2000).
- [10] A. Anders, *Cathodic Arcs: From Fractal Spots to Energetic Condensation* (Springer, New York, 2008).
- [11] R.H. Fowler and L. Nordheim, Proc. R. Soc. Lond. A: Math. Phys. Eng. Sci. 119, 173 (1928).
- [12] G.A. Mesyats, Plasma Phys. Control. Fusion 47, A109 (2005).
- [13] S. Cohen et al., J. Nucl. Mater. 76, 459 (1978).
- [14] G. McCracken and D. Goodall, Nucl. Fusion 18, 537 (1978).
- [15] P. Staib and G. Staudenmaier, J. Nucl. Mater. 76, 78 (1978).
- [16] P. Mioduszewski *et al.*, J. Nucl. Mater. **85**, 963 (1979).
- [17] K. Jakubka and B. Jüttner, J. Nucl. Mater. 102, 259 (1981).
- [18] G. McCracken, J. Nucl. Mater. 93, 3 (1980).
- [19] R. Behrisch et al., J. Nucl. Mater. 145, 731 (1987).
- [20] G. Federici et al., Nucl. Fusion 41, 1967 (2001).
- [21] K. Ertl et al., Nucl. Fusion 25, 1413 (1985).
- [22] B. Jüttner et al., Contrib. Plasma Phys. 34, 472 (1994).
- [23] S. Kajita et al., Nucl. Fusion 49, 095005 (2009).
- [24] D. Hwangbo et al., Nucl. Fusion 58, 096022 (2018).
- [25] S. Kajita *et al.*, Nucl. Fusion **58**, 106002 (2018).
- [26] M. Laux et al., IEEE Trans. Plasma Sci. 33, 1470 (2005).
- [27] A. Herrmann *et al.*, J. Nucl. Mater. **390**, 747 (2009).
- [28] V. Rohde et al., J. Nucl. Mater. 415, S46 (2011).
- [29] V. Rohde *et al.*, J. Nucl. Mater. **438**, S800 (2013).
- [30] M. Mayer *et al.*, Phys. Scr. T138, 014039 (2009).
- [31] I. Bykov et al., Phys. Scr. T170, 014034 (2017).
- [32] D. Rudakov *et al.*, J. Nucl. Mater. **438**, S805 (2013).
- [33] S. Kajita et al., Plasma Fusion Res. 7, 2405121 (2012).
- [34] S. Kajita *et al.*, Nucl. Fusion, **53**, 053013 (2013).
- [35] T. Akiyama et al., Rev. Sci. Instrum. 78, 103501 (2007).
- [36] I. Monakhov *et al.*, AIP Conf. Proc. **933**, 151 (2007).
- [37] D. Hwangbo et al., Plasma Fusion Res. 15, 2402012 (2020).
- [38] Y. Hayashi et al., accepted to Plasma Fusion Res.
- [39] S. Kajita et al., Nucl. Fusion 49, 095005 (2009).
- [40] S. Kajita et al., Results Phys. 6, 877 (2016).
- [41] D. Hwangbo et al., IEEE Trans. Plasma Sci. 45, 2080 (2017).
- [42] S. Kajita et al., Nucl. Fusion 49, 032002 (2009).
- [43] M. Tokitani et al., Nucl. Fusion 51, 102001 (2011).
- [44] D. Rudakov et al., Phys. Scr. T167, 014055 (2016).
- [45] J. Matějíček et al., J. Nucl. Mater. 492, 204 (2017).
- [46] D. Hwangbo et al., IEEE Trans. Plasma Sci. 47, 3617 (2019).
- [47] D. Hwangbo et al., Contrib. Plasma Phys. 58, 608 (2018).
- [48] S. Kajita *et al.*, Plasma Phys. Control. Fusion 54, 035009 (2012).
- [49] D. Aussems et al., J. Nucl. Mater. 463, 303 (2015).
- [50] M. Yajima et al., Fusion Eng. Des. 112, 156 (2016).
- [51] S. Kajita et al., Phys. Let. A 373, 4273 (2009).
- [52] S. Kajita *et al.*, Plasma Phys. Control. Fusion 53, 074002 (2011).
- [53] D. Hwangbo et al., Result. Phys. 4, 33 (2014).
- [54] D. Nishijima and R.P. Doerner J. Phys. D: Appl. Phys. 48, 325201 (2015).
- [55] D. Hwangbo et al., Plasma Sources Sci. Tech. 29, 125015

(2020).

- [56] S.A. Barengolts et al., Nucl. Fusion 50, 125004 (2010).
- [57] S.A. Barengolts *et al.*, IEEE Trans. Plasma Sci. **46**, 4044 (2018).
- [58] G.De Temmerman *et al.*, Plasma Phys. Control. Fusion 60, 044018 (2018).
- [59] G.De Temmerman et al., Nucl. Mater. Energy 19, 255

をどうやって減らすかが最近のもっともの悩みです.

(2019).

- [60] D. Hwangbo et al., Nucl. Mater. Energy 18, 250 (2019).
- [61] D. Sinelnikov *et al.*, IEEE Trans. Plasma Sci. 47, 5186 (2019).
- [62] R. Zhang *et al.*, The 29th Int. Toki Conf. Plasma Fus. Oct 27-30, Toki, Japan (2020).
- [63] K.B. Woller et al., Nucl. Fusion 57, 066005 (2017).